

## RFMD アナリストデイ・プレスリリース



rfmd.com

### 会社連絡先：

RF Micro Devices Inc.  
Brian K. Cockman, Public Relations Specialist  
7628 Thorndike Road  
Greensboro, NC 27409-9421, USA  
電話: +1 (336) 678-8945  
[bcockman@rfmd.com](mailto:bcockman@rfmd.com)

### **RFMD 社、WCDMA、WiMAX、移動無線用 GaN パワーアンプファミリーを発表**

ノースカロライナ州グリーンズボロ、2006年11月28日：移動通信駆動用各種アプリケーション向けの高性能無線システム/ソリューションを設計、製造し業界をリードするRFMD社（ナスダック：RFMD）は本日、WiMAXのティア1事業者、携帯電話基地局、公共業務用移動無線（PMR）の各顧客向けとなる窒化ガリウム（GaN）広帯域パワーアンプICの市場投入とサンプル供給開始を発表した。このパワーアンプファミリーは従来のガリウム砒素（GaAs）デバイスやシリコンLDMOS製品に比べ、広帯域での利得、出力電力、効率が優れている。

「このGaNプロセス技術により、当社はより経済性に優れ効率的な次世代無線インフラ展開の要求を満足する広帯域、高出力のソリューションを提供できるようになりました。」とRFMD社のインフラプロダクトグループ担当副社長 Jeff Shealy は語る。「RFMDのGaNパワーICは最大限の出力、帯域、効率の確保が求められる広帯域アプリケーション向けにシンプルな単一アンプのソリューションを提供します。」

新ファミリーに含まれるデバイスはRF3821（2.3~2.7GHz、1dB利得圧縮時の出力が8WのWiMAX用PA）、RF3823（3.3~3.8GHz、1dB利得圧縮時の出力が8WのWiMAX用PA）、RF3822（100~1000MHz、業務用移動無線向け飽和出力14WのPA）、RF3820（1.8~2.2GHz携帯電話用、1dB利得圧縮時の出力が8WのPA）の4種類。WiMAX用の2種類のパワーアンプICはいずれも2.5% EVM、リニア出力29dBmで、複数帯域にわたり11dBの広帯域利得が得られる。携帯電話用のパワーアンプICはいずれも-50dBc ACPR時のリニア出力が27dBmで、またDCS、PCS、W-CDMAの全帯域で13dBの広帯域利得が得られる。業務移動無線（PMR）用のアンプICは飽和出力が12~14Wで広帯域利得は11.5dB、帯域中心の500MHzにおけるPAE（効率）は65%を達成している。これらアンプは供給電圧28V、動作帯域内で50Ωインタフェースを確保する内部整合付き、放熱特性を向上させる熱特性強化AINパッケージで供給される。

RFMDでは、GaNパワーアンプ製品の出荷開始を2007暦年中と想定している。

GaNプロセス技術の特長や価格に関する情報は[www.rfmd.com](http://www.rfmd.com)に記載されている。

**RFMD** について：RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ RFMD)は移動通信の主要アプリケーション向けに高性能な無線システム/ソリューションの設計、製造を行う会社で、この業界のグローバル・リーダー。RFMD社のパワーアンプ、送信モジュール、携帯電話用トランシーバ、およびシステム・オン・チップ(SOC)ソリューションは現在および次世代の携帯端末、基地局、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、全地球測位システム(GPS)などの最新機能をサポートし、全世界的なモビリティの向上と接続性の拡大に寄与するもの。最先端の半導体技術による幅広い製品ラインと無線システムの豊富な経験で定評のあるRFMD社は、現在および将来の市場要求を満たす最新無線機能のサプライヤーとして、世界中の主要な移動通信機器メーカーから選ばれている。

ノースカロライナ州グリーンズボロに本社を置くRFMD社はISO 9001 およびISO 14001 の認証取得済みのメーカーで、世界各地にエンジニアリング、設計、販売、サービスの拠点を持つ。RFMD社はRFMD銘柄で米ナスダックグローバルセレクト市場に上場しています。なお詳しい情報はRFMD社のホームページ、[www.rfmd.com](http://www.rfmd.com)に紹介されている。

このプレス・リリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act)がその免責条項として定める「将来的な予測」が含まれています。この「将来的な予測」には当社の計画、目的、説明、主張などについて、またはそれ以外についての記述が含まれていますが、これらの記述は歴史的な事実ではなく、通常は「可能」、「必要」、「予測」、「期待」、「予定」、「計画」、「推測」、「確信」、「推定」、「予想」、「可能性」、「継続」などの用語や類似の用語とともに使用されています。またこれらとは別の表現で「将来的な予測」が記述される場合もあります。この文書に含まれている「将来的な予測」の記述は現時点における経営陣の判断や期待を表していますが、実際の成果や出来事、業績などはこれら記述で表現されたり暗示されたりした内容とは実質的に異なる場合があります。当社は米国連邦証券取引法により要求される場合を除き、これら「将来的な予測」の記述内容を改訂したり、あるいはその記述の改訂を公表したりする意図を持っていません。RFマイクロデバイセス社の事業には多くのリスクや不確定性が内在しており、その内容には四半期毎の経営成果の変動、無線関連市場の発展や成長率、ウェハ製造施設、分子線エピタキシー施設、組み立て施設、試験、テープ、リール施設など各種製造施設の稼働に関するリスク、熟練技術者や開発リーダーを採用・確保する当社の能力、生産歩留りの変動、革新的技術によりコストを削減し正味利益率を改善する能力、新製品を市場に投入する能力、製品需要に即応したタイムリーな生産能力の調整を行う能力、限られた顧客への依存性、サードパーティへの依存性などが含まれています。上記以外も含むこれらリスクや不確定性については米国証券取引委員会の様式10-Kに従ったRFマイクロデバイセス社の最新アニュアルレポートの中で説明されていますが、このような不確定性のため、これら記述の表現や暗示による内容と実際の成果や出来事、業績とは実質的に異なる場合があります。

**RF MICRO DEVICES®** および**RFMD®**はRFMD, LLCの商標である。その他の商品名、商標、登録商標はそれぞれの所有者の財産である。

###